

(19)日本国特許庁(J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2002 - 40964

(P2002 - 40964A)

(43)公開日 平成14年2月8日(2002.2.8)

| (51)Int.Cl. ⁷ | 識別記号 | F I | テ-マ-ト [*] (参考) |
|--------------------------|------|---------------|---------------------------|
| G 0 9 F 9/30 | 365 | G 0 9 F 9/30 | 365 Z 3 K 0 0 7 |
| H 0 5 B 33/04 | | H 0 5 B 33/04 | 5 C 0 9 4 |
| 33/10 | | 33/10 | |
| 33/14 | | 33/14 | A |

審査請求 未請求 請求項の数 8 O L (全 6 数)

(21)出願番号 特願2000 - 230239(P2000 - 230239)

(22)出願日 平成12年7月31日(2000.7.31)

(71)出願人 000153878

株式会社半導体エネルギー研究所

神奈川県厚木市長谷398番地

(72)発明者 筒井 哲夫

福岡県春日市紅葉ヶ丘東8丁目66番

(72)発明者 隅岡 和宏

福岡県福岡市城南区友岡1 - 8 - 56 - 202

(74)代理人 100102336

弁理士 久保田 直樹 (外 1 名)

F タ-ム (参考) 3K007 CA01 CB01 DA02 EB05

5C094 AA06 AA10 AA22 AA37 AA43

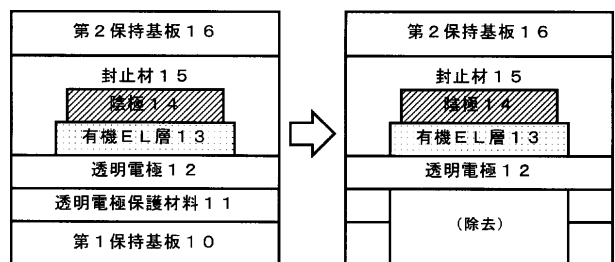
BA29 EA04 EA05 EA07

(54)【発明の名称】 表示素子および表示素子の製造方法

(57)【要約】

【課題】有機EL層にダメージを与えることなく、発生した光を効率良く外部へ放出可能な表示素子および表示素子の製造方法を提供すること。

【解決手段】第1保持基板10上にまず透明電極保護材料11を成膜し、その上に従来の素子例と同様の順序で有機EL発光素子(12,13,14)を製造し、封止材15、第2保持基板16によって封止、保持を行った後に、第1保持基板10、透明電極保護材料11をエッチング等によって取り除く。本発明によれば、第1保持基板10を除去することにより、EL層13において発生した光の取り出し効率が向上し、表示素子の輝度やコントラストが向上する。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】発光素子の発光面と反対側の面を封止すると共に保持する素子保持手段を有することを特徴とする表示素子。

【請求項 2】前記発光素子は、透明電極層、有機 EL 層、陰極層からなることを特徴とする請求項 1 に記載の表示素子。

【請求項 3】前記素子保持手段は、保持基板および前記発光素子の裏面を封止すると共に発光素子と保持基板とを接着する封止材からなることを特徴とする請求項 1 に記載の表示素子。

【請求項 4】前記透明電極層は、部分的に形成された透明電極パターンと、当該透明電極パターン以外の領域に設けられた有機 EL 層保護材料層からなることを特徴とする請求項 2 に記載の表示素子。

【請求項 5】前記透明電極層は、部分的に形成された透明電極パターンからなり、更に、前記透明電極層の外側の当該透明電極パターン以外の領域に保持基板層を設けたことを特徴とする請求項 2 に記載の表示素子。

【請求項 6】基板側に光を放出する発光素子を基板上に形成するステップと、前記発光素子を前記基板と反対側から保持するステップと、前記基板の少なくとも一部を除去するステップとからなることを特徴とする表示素子の製造方法。

【請求項 7】前記発光素子は、透明電極、有機 EL 層、陰極からなることを特徴とする請求項 5 に記載の表示素子の製造方法。

【請求項 8】前記基板は、保持基板および透明電極保護材料層からなることを特徴とする請求項 7 に記載の表示素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は表示素子および表示素子の製造方法に関し、特に、発生した光を効率良く外部へ放出可能な表示素子および表示素子の製造方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】従来、例えば発光素子として有機 EL 素子等を使用した表示素子は通常ガラス基板上に成膜されていた。図 2 は、従来の表示素子の構成および動作を示す説明図である。図 2 (a) は、従来の第 1 の素子構成例を示す説明図である。なお、図における各層の厚さは誇張して描いてあり、実際の比率とは異なっている。

【0003】従来の成膜の順序は、ガラス基板 30 上に透明電極 31 (例えばITO:酸化インジウムと酸化錫との合金)をスパッタリングした後、有機EL層 32 を蒸着あるいはスピンコートで成膜し、陰極 33 を蒸着する。その後、封止材 34 を用いて対向基板 35 を貼りつけ、有機

EL層 32 および陰極 33 の大気中での劣化を防ぐ。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】図 2 (b) は、従来の第 1 素子例における光路を示す説明図である。上記したような従来の構造において、陰極 33 の材料は金属なので、光はガラス基板 30 側から取り出されるが (図 2・光路 A)、各層の屈折率の相違により、臨界角より大きな角度をもって進む光は素子の前面に出ることができない (図 2・光路 B・光路 C)。従って、光の取り出し効率 $= 1 / (2n^2)$ 但し、 n は発光層 32 の屈折率 (約 1.6) となり、生じた光の約 80% はガラス基板 30 内を導波して横に逃げてしまうという問題点があった。

【0005】この問題点を避けるために、ガラス基板上に陰極から逆の順序で成膜する方法が提案されている。図 2 (c) は、従来の第 2 の素子構成例を示す説明図である。成膜の順序は、ガラス基板 30 上にまず陰極 36 を蒸着する。そして、有機EL層 37 を蒸着あるいはスピンコートで成膜した後、例えばITOなどの透明電極 31 をスパッタリングにて成膜する。この場合、有機EL膜 37 上にITO等の透明導電膜 38 をスパッタリングする必要があるが、スパッタ時のダメージや温度上昇によって有機EL層 37 が変成するという問題点があった。

【0006】本発明の目的は、前記のような従来技術の問題点を解決し、有機EL層にダメージを与えることなく、発生した光を効率良く外部へ放出可能な表示素子および表示素子の製造方法を提供することにある。

【0007】

【課題を解決するための手段】本発明は、従来の第 1 素子例 (図 2 (a)) と同様の順序で発光素子を製造し、封止を行った後に、透明電極を形成するための保持基板をエッチング等によって取り除く点に特徴がある。

【0008】本発明によれば、透明電極を形成するための保持基板を除去することにより、EL層において発生した光の取り出し効率が向上し、表示素子の輝度やコントラストが向上する。

【0009】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を詳細に説明する。図 1 は、本発明の表示素子の第 1 実施例の製造方法および構成を示す説明図である。本発明の第 1 実施例の有機 EL 表示素子の成膜の順序は、まず、例えばガラスからなる第一保持基板 10 上に透明電極保護材料 11 を成膜し、その上に透明電極 12 をスパッタリングした後、有機EL層 13 を蒸着あるいはスピンコートで成膜し、陰極 14 を蒸着する。その後、封止材 15 を用いて第 2 保持基板 16 を貼りつける。そして、第 1 保持基板 10 および透明電極保護材料を順にエッチングして除去する。

【0010】<第一保持基板>第一保持基板 10 は、表面平滑度が高ければ (通常の透明電極付きガラス基板程度) ガラス以外に、金属や無機物、ポリマーの基板でも

良い。ただし、例えば第二保持基板 16 による封止後に、部分的あるいは全体的に除去できる必要がある。第一保持基板 10 は最終的に取り除くものであるから、封止まで発光素子 (12 ~ 14) を保持できるだけの強度さえあれば、厚みは薄いほど良い。第一保持基板 10 のエッチングにおいては、**パターンニング無しですべて取り***

*除いても良いし、例えば発光部分のみを部分的に取り除いてもよい。第一保持基板 10 として使用可能な材料例を表 1 に示す。

【0011】

【表 1】

| 材 料 | | エッチャント |
|-------------|--------------|-----------------|
| ガラス、 無機物 | シリカガラス | フッ化水素酸・フッ硝酸 |
| | 酸化チタン (チタニア) | 熱濃硫酸・水酸化ナトリウム |
| | シリコン | フッ化水素酸・フッ硝酸 |
| 金 属 | アルミニウム | 塩酸・希硫酸・硝酸 |
| | チタン | フッ化水素酸 |
| ポリマー | PMMA | トルエン・クロロホルム |
| | ポリカーボネート | クロロホルム・アセトン・DMF |

【0012】<透明電極保護材料> 第一保持基板 10 に例えばスピンコートにより成膜する透明電極保護材料 11 は、第一保持基板 10 のエッチャント (エッチング剤) に耐性があり、透明電極 12 の成膜時の熱や光 (スパッタの際のプラズマ光など) に耐えられるものがよい。

【0013】透明電極保護材料 11 の役割は、第一保持基板 10 をエッチングする際のエッチングストッパーであるので、第一保持基板 10 のエッチング時に透明電極 12 を溶かさないうエッチャントが使える場合や、エッチ*

ングの完全な時間制御が可能な場合には無くても良い。

【0014】透明電極保護材料 11 は、第一保持基板 10 のエッチング後に、取り除けるものが良い。透明電極保護材料 11 は、完全に取り除く場合には不透明でも良い。また、厚み方向に部分的に取り除く場合には、透明である必要はないが、可視光域に吸収が無い方が良い。透明電極保護材料 11 として使用可能な材料を表 2 に示す。

【0015】

【表 2】

| 材 料 | エッチャント |
|-------------|---------------------------------|
| ノルボルネン系ポリマー | トルエン・クロロホルム |
| ポリスチレン | トルエン・THF |
| ポリカーボネート | クロロホルム・アセトン・DMF |
| 銅フタロシアニン | クロロホルム・アセトン |
| レジスト材料 | アセトン |
| アクリル | (O ₂ プラズマでのドライエッチング) |

【0016】<透明電極> 例えばITOからなる透明電極 12 の膜厚は例えば80nm ~ 150nm程度であり、膜内の導波光をおさえるために、透明電極 12 自体の膜厚は薄い方がよい。なお、透明電極 12、有機EL層 13、例えば金属からなる陰極 15 については従来公知の有機EL発光素子と同一の材料および成膜方法を採用可能である。

【0017】<封止材> 封止材は第一保持基板と透明電極保護材料のエッチャントに耐性があるものを用いることが望ましい。耐性のないものを用いる場合は、基板の側面の封止材がむき出しの部分の保護してから、第一保持基板と透明電極保護材料のエッチングを行う。封止材の材質としては、例えばエポキシ樹脂、光硬化型エポキシ樹脂、光硬化型アクリル樹脂等を使用可能である。

<第二保持基板> 第二保持基板 16 は、第一保持基板 1

0 とエッチャントが異なるものが望ましい。第二保持基板 16 が第一保持基板 10 のエッチャントに耐性があれば、第一保持基板 10 のエッチング時に、第二保持基板 16 の保護を考慮せずに済むので、処理が簡便になる。

第一保持基板 10 と透明電極保護材料 11 のエッチング後に封止材 15 のみで強度を保つことができる場合には、第二保持基板 16 は無くても良い。第 2 保持基板 16 の材質としては、例えばガラス板、アルミニウム等の金属板、ポリエチレン、ポリカーボネート、ポリイミドなどのポリマー板を使用可能である。なお、封止材および第 2 保持基板にプラスチックを使用することによってフレキシブル (変形可能) な表示素子を製造することができる。第 1 実施例の表示素子は図 1 に示すような構成によって、透明電極 12 が露出しているの、従来の表示素子においてガラス基板 30 内を導波していた光

(図 2 (b) の光路 B) はほとんどが透明電極を通して外部へ放出され、従来と比べて光取り出し効率が向上する。

【0018】次に、第 2 実施例について説明する。図 3 は、単純マトリクス構成の場合の問題点を示す説明図である。単純マトリクスのように、複数の画素を独立にアドレスする場合には、透明電極 12 のパターンニングが必要になる。この場合、透明電極保護材料 11 のエッチング時に有機 EL 層 13 がエッチャントに直接触れることになる上に、光の取り出し側に有機 EL 層 13 がむき出し 10 の部分ができてしまうという問題点がある。

【0019】図 4 は、単純マトリクス構成の場合の本発明の表示素子の第 2 実施例の構成を示す説明図である。有機 EL 層 13 を透明電極保護材料 11 のエッチャントから保護し、有機 EL 層 13 の大気暴露を防ぎたい場合は、透明電極 12 のパターンニング後に透明電極 12 を形成しなかった部分に有機 EL 保護材料 17 の成膜を行う。有機 EL 保護材料 17 の膜厚は、有機 EL 層 13、陰極 14 の膜切れを防ぐため、例えば 150nm など、透明電極 12 と有機 EL 層 13 を合わせた膜厚より薄いものが望ましい。保護材料 17 の材質としては、例えばシリカガラス、アクリル樹脂、ポリイミド樹脂などを使用可能である。

【0020】次に、第 3 実施例について説明する。図 5 は、単純マトリクス構成の場合の本発明の表示素子の第 3 実施例の構成を示す説明図である。有機 EL 保護材料 17 を用いない場合は、有機 EL 層 13 が露出しないように、第一保持基板 10、透明電極保護材料 11 のエッチングを部分的に行い、透明電極 12 のある部分だけ第一保持基板 10 および透明電極保護材料 11 を取り除く。

【0021】図 5 は透明電極 12 上の第一保持基板 10 30 および透明電極保護材料 11 をライン状に取り除いて、孔 20 を形成した例であり、上図は B - B 断面図、下図は表示素子を第一保持基板 10 側から見た図である。下図においては省略して描かれているが、数十～数百本の陰極 14 および透明電極 12 を格子状に配置することにより、単純マトリクスが構成される。孔 20 はライン状ではなく、陰極 14 と透明電極 12 の重なる領域の部分にのみ長方形 (正方形) に設けてもよい。

【0022】図 5 のような構成とした場合には、第一保持基板 10 および透明電極保護材料 11 は発光領域の周 40 囲を覆うことになるので、少なくともどちらか一方を例えば黒色とすることによって、表示素子のコントラストが向上する。

【0023】図 6 は、本発明の表示素子の第 4 実施例の構成を示す説明図である。第 4 の実施例は、透明電極のパターンニングなしで、発光部位を制御する方法である。第 4 の実施例においては、全面に形成した透明電極 12 上の光らせたくない部分に SiO₂、レジストなどの絶縁膜 21 を挟む方法である。この場合、有機 EL 層 13 成膜時の膜切れを起こさないために、絶縁層 21 の膜厚は 100n 50

m 以下が望ましい。この方式では、透明電極 12 は電位印可が全面にわたって行われるので、発光領域の部分的な制御は行えず、固定静止画あるいは面発光の用のパターンニング方法となる。

【0024】次に、各層の材質の具体的な組み合わせ例およびその製造工程について説明する。材質例 1 は、第 1 実施例の表示素子について、第一保持基板 10 としてガラス、透明電極保護材料 11 としてポリスチレン、第二保持基板 16 としてアルミニウムを使用した例である。

【0025】<材質例 1>

1. 第一保持基板 (ガラス) 上に透明電極保護材料 (ポリスチレン) をスピンコートする。
2. 1 の基板上に透明電極 (ITO) をスパッタリングする。
3. 2 の基板上に有機 EL 層を作製する。
4. 3 の基板上の有機 EL 層を封止した後、第二保持基板 (アルミニウム) で基板を保持する。
5. 4 の基板の第一保持基板をフッ化水素酸で溶かす。
6. 5 の基板のポリスチレンをトルエンで溶かす。

材質例 2 は、第 2 実施例の表示素子について、第一保持基板 10 としてアルミニウム、透明電極保護材料 11 としてポリカーボネート、第二保持基板 16 としてガラスを使用した例である。

【0026】<材質例 2>

1. 第一保持基板 (アルミ) 上に透明電極保護材料 (ポリカーボネート) をスピンコートする。
2. 1 の基板上に透明電極 (ITO) をスパッタリングする。
3. 2 の基板上の透明電極をパターンニングする。
4. 3 の基板上に有機 EL 保護材料 (SiO₂) をスパッタリングし、透明電極保護材料がむき出しの部分が被覆する。成膜後、透明電極層を覆った SiO₂ を逆スパッタし、透明電極の表面を出す。
5. 4 の基板上に、有機 EL 層を作製する。
6. 5 の基板上の有機 EL 層を封止した後、第二保持基板 (ガラス) で基板を保持する。
7. 6 の基板の第一保持基板 (アルミ) を塩酸で溶かす。
8. 7 の基板のポリカーボネートをトルエンで溶かす。

材質例 3 は、第 3 実施例の表示素子について、第一保持基板 10 としてガラス、透明電極保護材料 11 としてアクリル、第二保持基板 16 として酸化チタンを使用した例である。

【0027】<実施例 3>

1. 第一保持基板 (ガラス) 上に透明電極保護材料 (アクリル) をスピンコートする。
2. 1 の基板上に透明電極 (ITO) をスパッタリングする。
3. 2 の基板上の透明電極をパターンニングする。
4. 3 の基板上に、有機 EL 層を作製する。
5. 4 の基板上の有機 EL 層を封止した後、第二保持基板 (酸化チタン) で基板を保持する。

6. 5の基板の第一保持基板(ガラス)をレジストでパターニングし、透明電極がある部分だけエッチングを行った後、レジストを取り除く。

7. 6の基板のアクリルを、第一保持基板が取り除かれた部分だけ0₂プラズマで取り除く。

【0028】

【発明の効果】本発明においては、上記した構成によって、第一保持基板が取り除かれ、透明電極が十分に薄ければ、導波光がなくなり、EL層から出た光の取り出し効率が向上するという効果がある。そして、取り出し効率を上げることで、通常の素子と同じ輝度を低電圧で得ることができ、素子の長寿命化・省電力化につながるという効果がある。また、従来例で述べた陰極から成膜する方法で問題となっていた、有機EL層上へ透明導電膜をスパッタ等で成膜する際のダメージを、本発明の方法では考慮しなくて良いという効果もある。更に、プラスチック基板を使用して表示素子を製造する場合、透明電極成膜時の温度を低くしなければいけない問題があったが、本発明ではこれを考慮せずに第二保持基板をポリマー基

*板にすることで実現できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の表示素子の第1実施例の構成を示す説明図である。

【図2】従来の表示素子の構成および動作を示す説明図である。

【図3】単純マトリクス構成の場合の問題点を示す説明図である。

【図4】本発明の表示素子の第2実施例の構成を示す説明図である。

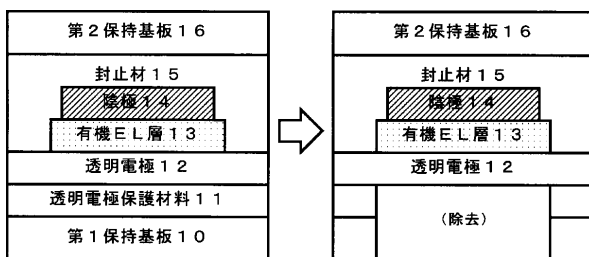
【図5】本発明の表示素子の第3実施例の構成を示す説明図である。

【図6】本発明の表示素子の第4実施例の構成を示す説明図である。

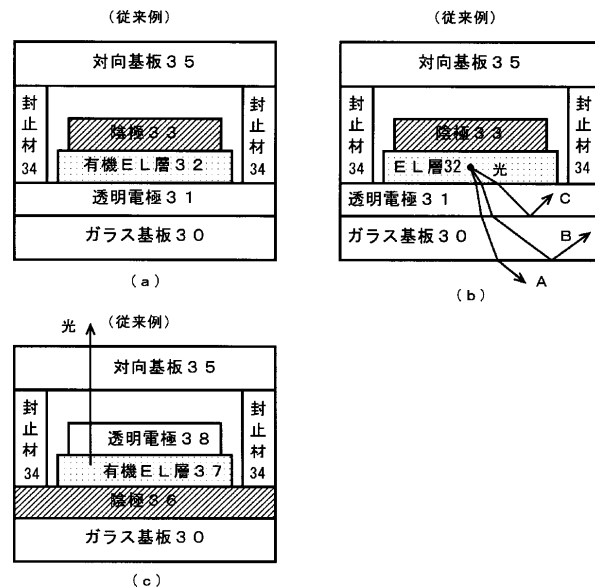
【符号の説明】

10...第一保持基板、11...透明電極保護材料、12...透明電極、13...有機EL層、14...陰極、15...封止材、16...第2保持基板、20...孔

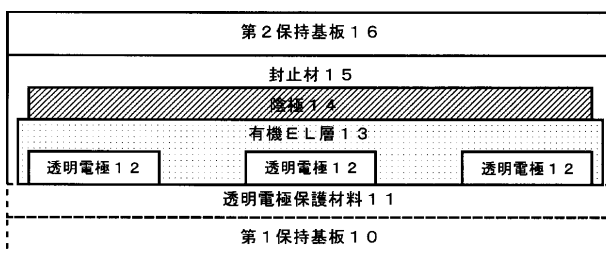
【図1】



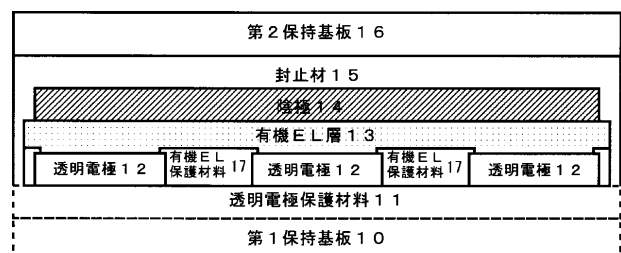
【図2】



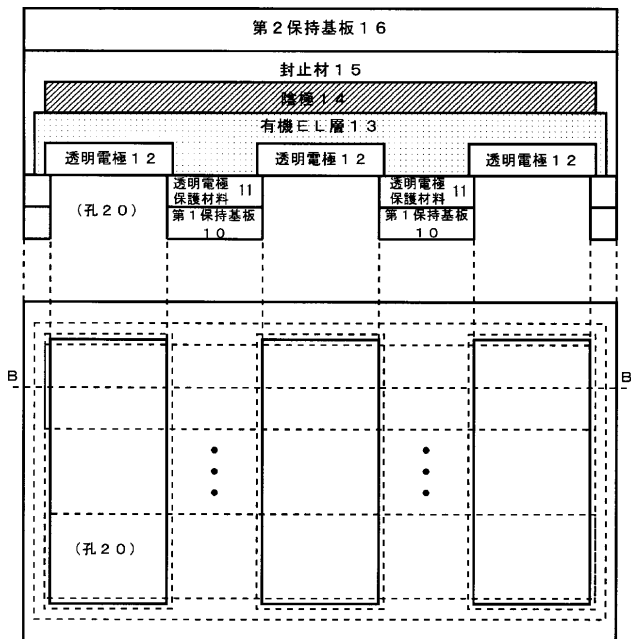
【図3】



【図4】



【図 5】



【図 6】



| | | | |
|----------------|---|---------|------------|
| 专利名称(译) | 显示元件和制造显示元件的方法 | | |
| 公开(公告)号 | JP2002040964A | 公开(公告)日 | 2002-02-08 |
| 申请号 | JP2000230239 | 申请日 | 2000-07-31 |
| [标]申请(专利权)人(译) | 株式会社半导体能源研究所 | | |
| 申请(专利权)人(译) | 半导体能源研究所有限公司 | | |
| [标]发明人 | 筒井哲夫 隅岡和宏 | | |
| 发明人 | 筒井 哲夫 隅岡 和宏 | | |
| IPC分类号 | H05B33/04 G09F9/30 H01L27/32 H01L51/50 H01L51/52 H05B33/10 H05B33/14 | | |
| CPC分类号 | H01L51/52 H01L27/3281 H01L51/003 H01L51/5246 H01L51/5253 H01L51/5262 H01L2227/326 | | |
| FI分类号 | G09F9/30.365.Z H05B33/04 H05B33/10 H05B33/14.A G09F9/30.365 H01L27/32 | | |
| F-TERM分类号 | 3K007/CA01 3K007/CB01 3K007/DA02 3K007/EB05 5C094/AA06 5C094/AA10 5C094/AA22 5C094/AA37 5C094/AA43 5C094/BA29 5C094/EA04 5C094/EA05 5C094/EA07 3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC02 3K107/CC05 3K107/CC32 3K107/CC45 3K107/DD02 3K107/DD22 3K107/EE42 3K107/EE55 3K107/GG28 | | |
| 其他公开文献 | JP2002040964A5 JP4766628B2 | | |
| 外部链接 | Espacenet | | |

摘要(译)

要解决的问题：提供一种能够在不损坏有机EL层的情况下有效地将发射的光辐射到外部的显示元件，并提供一种制造方法。解决方案：在第一保持基板10上沉积透明电极保护材料11；以与传统元件实例类似的顺序在其上制造有机EL发光元件（12,13,14）；在通过密封剂15和第二保持基板10进行密封和保持之后，通过蚀刻等去除第一保持基板和透明电极保护材料11。根据本发明，通过去除第一保持基板10，提高了在EL层13上产生的光的取出效率，并且提高了显示元件的亮度和对比度。

